

Козлов Роман Юрьевич

**Разработка основ комплексной опытно-промышленной технологии получения
полированных пластин антимонида индия диаметром до 100мм для фотоприемных
устройств средневолнового ИК диапазона**

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

Специальность **2.2.3 - «Технология и оборудование для производства материалов и
приборов электронной техники»**

Работа выполнена на кафедре материаловедения полупроводников и диэлектриков НИТУ
МИСИС

Научный руководитель: профессор кафедры материаловедения полупроводников и
диэлектриков НИТУ МИСИС, д.ф.-м.н. Пархоменко Юрий Николаевич

Экспертная комиссия:

1. Кожитов Лев Васильевич - д.т.н., профессор кафедры технологии материалов электроники НИТУ МИСИС - председатель комиссии;
2. Саранин Данила Сергеевич - д.т.н., профессор кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ МИСИС, заведующий лабораторией перспективной солнечной энергетики НИТУ МИСИС;
3. Простомолотов Анатолий Иванович - д.т.н., ведущий научный сотрудник лаборатории механики новых материалов и технологий, Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН;
4. Каневский Владимир Михайлович - д.ф.-м.н., руководитель отделения Институт кристаллографии Курчатовского комплекса кристаллографии и фотоники НИЦ «Курчатовский институт»;
5. Маренкин Сергей Федорович - д.х.н., главный научный сотрудник лаборатории полупроводниковых и диэлектрических материалов федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук.

Ведущее предприятие:

акционерное общество «Оптрон», г. Москва

Защита диссертации состоится «20» мая 2026 года по адресу 119049, г. Москва,
Ленинский проспект, д. 6, стр. 2.